



DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets ⁶ : H01L 21/762		A1	(11) Numéro de publication internationale: WO 99/03148 (43) Date de publication internationale: 21 janvier 1999 (21.01.99)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR98/01475 (22) Date de dépôt international: 8 juillet 1998 (08.07.98)		(81) Etats désignés: JP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Publiée <i>Avec rapport de recherche internationale.</i>	
(30) Données relatives à la priorité: 97/08642 8 juillet 1997 (08.07.97) FR			
(71) Déposant (<i>pour tous les Etats désignés sauf US</i>): FRANCE TELECOM [FR/FR]; 6, place d'Alleray, F-75015 Paris (FR).			
(72) Inventeurs; et (75) Inventeurs/Déposants (<i>US seulement</i>): SCHIAVONE, Patrick [FR/FR]; 3, rue Victor Favier, F-38190 Villard-Bonnot (FR). GAILLARD, Frédéric [FR/FR]; 67, rue Jean Jaurès, F-38500 Voiron (FR).			
(74) Mandataire: BUREAU D.A. CASALONGA JOSSE; 8, avenue Percier, F-75008 Paris (FR).			

(54) Title: METHOD FOR MINIMISING CORNER EFFECT BY DENSIFYING THE INSULATING LAYER

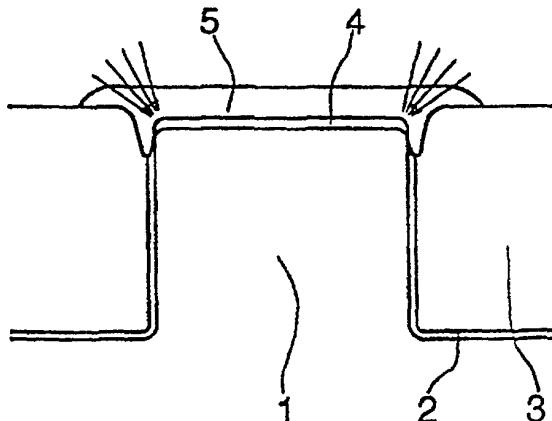
(54) Titre: PROCEDE DE MINIMISATION DE L'EFFET DE COIN PAR DENSIFICATION DE LA COUCHE ISOLANTE

(57) Abstract

The invention concerns a method for minimising "corner" effect in shallow silicon oxide trenches, by densifying the silicon oxide layer after it has been deposited in the trenches. Said densification is preferably carried out by irradiating the layer under a luminous radiation with weak wavelength.

(57) Abrégé

La présente invention concerne un procédé permettant de minimiser l'effet de "coin" dans les tranchées peu profondes d'oxyde de silicium, par densification de la couche d'oxyde de silicium après son dépôt dans les tranchées. Cette densification s'effectue préférentiellement par irradiation de ladite couche sous un rayonnement lumineux de faible longueur d'onde.



ABSTRACT

The invention concerns a method for minimizing "corner" effects in shallow silicon oxide trenches, by densifying the silicon oxide layer after it has been deposited in the trenches. Said densification is preferably carried out by irradiating the layer under luminous radiation with weak wavelength.

卷之三